

# 2SC3245, 2SC3245A

プリドライブ用  
シリコンNPNエピタキシャル形

## 概要

2SC3245、2SC3245Aは、樹脂封止形のシリコンNPNエピタキシャル形トランジスタです。高耐圧、高 $h_{FE}$ で、 $h_{FE}$ の直線性が非常に良く、また $f_T$ が高く、 $C_{ob}$ が小さく設計、製造されていますので、HiFiパワーアンプのプリドライブ段、トーンコントロールアンプ、イコライザアンプの終段等に2SA1285、2SA1285Aとコンプリメンタリで使用するのに最適です。

## 特長

- 高 $f_T$ 、小 $C_{ob}$   $f_T=200\text{MHz}$ 、 $C_{ob}=2.3\text{pF}$  標準
- 高 $h_{FE}$   $h_{FE}=150\sim 800$
- 高耐圧  $V_{CE0}=120\text{V}$ 、 $150\text{V}$
- コレクタ損失が大きい  $P_C=900\text{mW}$

## 用途

出力40W~80Wメインアンプのプリドライブ段、トーンコントロールアンプやイコライザの終段

## 最大定格 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

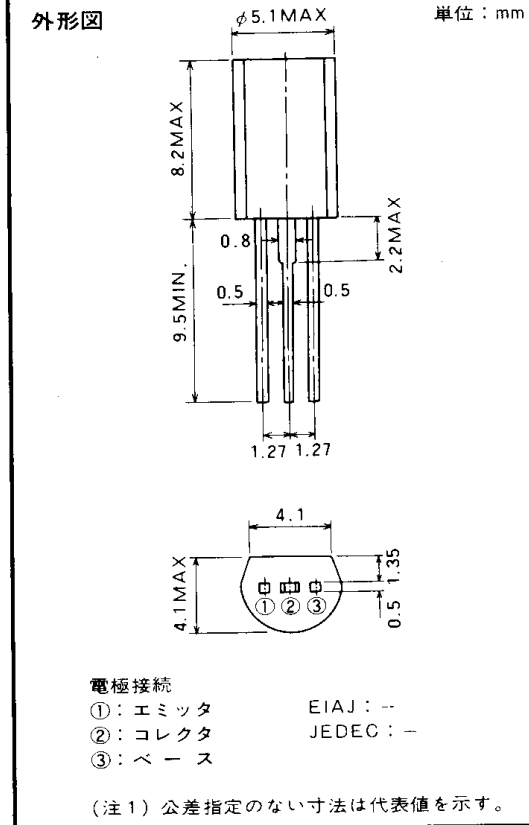
記号	項目	定格値		単位
		2SC3245	2SC3245A	
$V_{CB0}$	コレクタ・ベース間電圧	120	150	V
$V_{EB0}$	エミッタ・ベース間電圧	5	5	V
$V_{CE0}$	コレクタ・エミッタ間電圧	120	150	V
$I_C$	コレクタ電流	100		mA
$P_C$	コレクタ損失 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )	900		mW
$T_j$	接合部温度	+150		$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	保存温度	-55 ~ +150		$^\circ\text{C}$

## 電気的特性 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

記号	項目	測定条件	特性値						単位
			2SC3245			2SC3245A			
			最小	標準	最大	最小	標準	最大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C=10\mu\text{A}$ , $I_E=0$	120			150			V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E=10\mu\text{A}$ , $I_C=0$	5			5			V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C=1\text{mA}$ , $R_{BE}=\infty$	120			150			V
$I_{CB0}$	コレクタしゃ断電流	$V_{CB}=100\text{V}$ , $I_E=0$			0.1			0.1	$\mu\text{A}$
$I_{EB0}$	エミッタしゃ断電流	$V_{EB}=4\text{V}$ , $I_C=0$			0.1			0.1	$\mu\text{A}$
$h_{FE}$ †	直流電流増幅率	$V_{CE}=10\text{V}$ , $I_C=10\text{mA}$	150		800	150		500	—
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C=50\text{mA}$ , $I_B=2.5\text{mA}$		0.17	0.6		0.17	0.6	V
$f_T$	利得帯域幅積	$V_{CE}=10\text{V}$ , $I_E=-10\text{mA}$		200			200		MHz
$C_{ob}$	コレクタ出力容量	$V_{CB}=-10\text{V}$ , $I_E=0$ , $f=1\text{MHz}$		2.3			2.3		pF

†:  $h_{FE}$ の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	E	F	G
$h_{FE}$	150 ~ 300	250 ~ 500	400 ~ 800



This datasheet has been downloaded from:

[www.DatasheetCatalog.com](http://www.DatasheetCatalog.com)

Datasheets for electronic components.